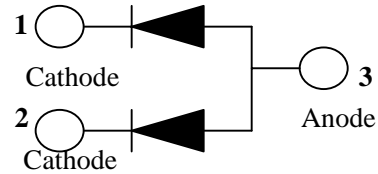




Schottky Diode



肖特基二极管(FHBAT54A)

MAXIMUM RATINGS 最大额定值

Rating 额定值	Symbol 符号	Value 值	Unit 单位
Reverse Voltage 反向电压	V_R	30	Vdc
Peak Forward Current 正向峰值电流	I_F	200	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Total Device Dissipation FR-5 Board(1) $T_A=25$	P_D	225	mW
Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) $T_A=25$ 总耗散功率 氧化铝衬底	P_D	300	mW
Junction and Storage Temperature 结温和储存温度	T_J, T_{stg}	150 , -55 to +150	

DEVICE MARKING 打标

FHBAT54A=2S

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

($T_A=25$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25)

Characteristic 特性	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位
-------------------	-----------	---------	---------	---------

OFF CHARACTERISTICS 截止电特性

Reverse Voltage Leakage Current 反向漏电流($V_R=25Vdc$)	I_R	—	1.0	μA_{dc}
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压($I_{BR}=10 \mu A_{dc}$)	$V_{(BR)}$	30	—	Vdc
Forward Voltage 正向电压 ($I_F=0.1mAdc$)	V_F	—	240	mVdc
($I_F=1mAdc$)		—	320	
($I_F=10mAdc$)		—	400	
($I_F=30mAdc$)		—	500	
($I_F=100mAdc$)		—	1000	
Total Capacitance 电容($V_R=1V, f=1.0MHz$)	C_T	—	10	pF
Reverse Recovery Time 反向恢复时间($I_F=I_R=10mAdc, R_L=100 \Omega$)	t_{rr}	—	5.0	ns

- FR-5=1.0 × 0.75 × 0.062 in.
- Alumina=0.4 × 0.3 × 0.024 in. 99.5% alumina.



SOT-23 封装外形尺寸 (SOT-23 DIMENSION)

